

D1FL20U**200V 1.1A****特長**

- 小型SMD
- 低ノイズ
- trr=35ns

Feature

- Small SMD
- Low Noise
- trr=35ns

用途

- スイッチング電源
- DC/DC コンバータ
- フライホール
- 家電、OA、照明
- 通信、FA

Main Use

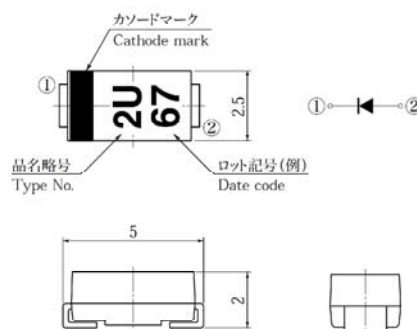
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Fly Wheel
- Home Appliance, Office Automation, Lighting
- Communication, Factory Automation

■外観図 OUTLINE

Package : 1F

Unit:mm

Weight 0.058g (Typ)



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings** (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D1FL20U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}			-55 ~ 150	$^\circ\text{C}$
接合部温度 Operation Junction Temperature	T_j			150	$^\circ\text{C}$
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V_{RM}			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I_o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, $T_a = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Resistance load, $T_a = 25^\circ\text{C}$	アルミナ基板実装 On alumina substrate	1.1	A
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	0.84	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I_{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 25^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 25^\circ\text{C}$		20	A

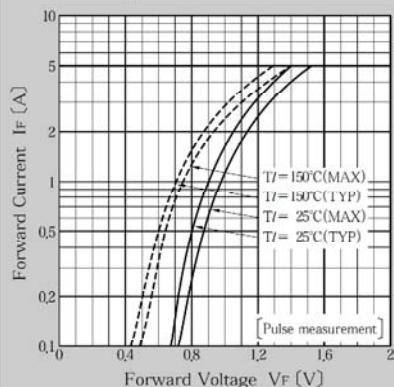
●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_I = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 1.1\text{ A}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.98	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{RM}$, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	$I_F = 0.5\text{ A}$, $I_R = 1\text{ A}$	MAX 35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 23	$^\circ\text{C/W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Junction to ambient	アルミナ基板実装 On alumina substrate	
			プリント基板実装 On glass-epoxy substrate	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

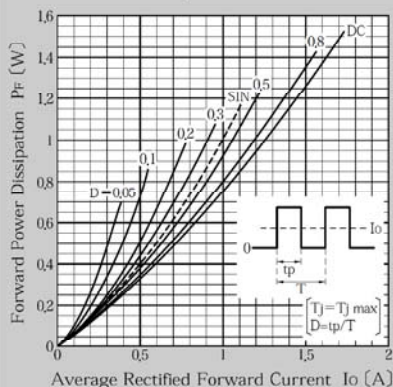
順方向特性

Forward Voltage



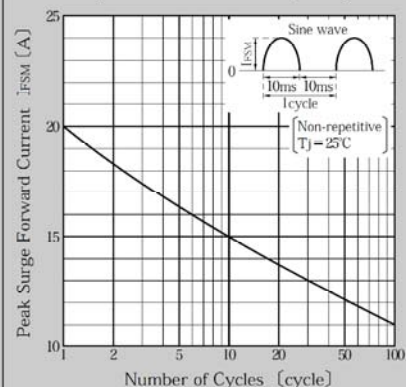
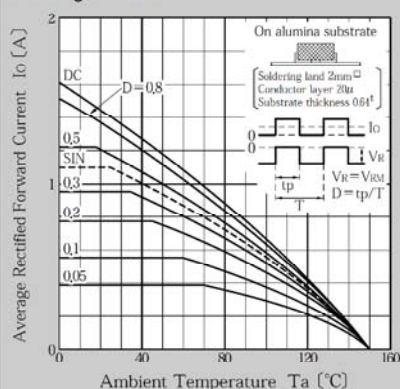
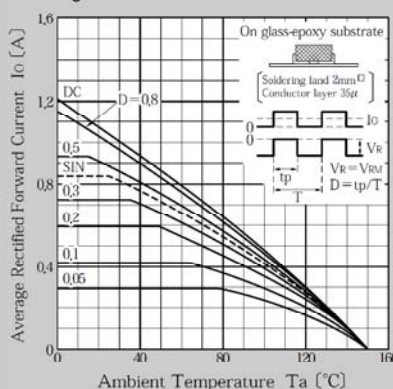
順電力損失曲線

Forward Power Dissipation



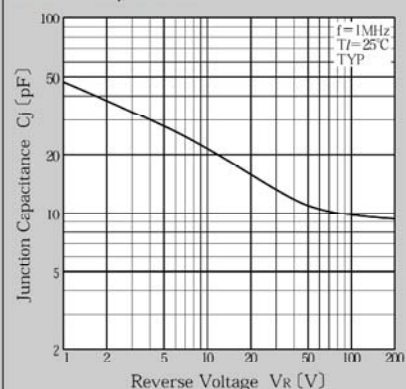
せん頭サージ順電流耐量

Peak Surge Forward Current Capability

ディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Ioディレーティングカーブ Ta-Io
Derating Curve Ta-Io

接合容量

Junction Capacitance



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical is statistical average of the device's ability.
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9